

2SC1879^H

シリコン NPN エピタキシャル形

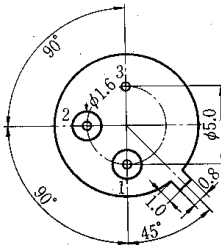
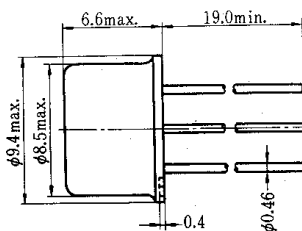
高利得増幅用

中速度電力スイッチング用

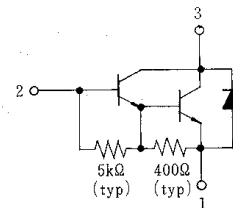
SILICON NPN EPITAXIAL

HIGH GAIN AMPLIFIER

MEDIUM SPEED POWER SWITCHING



1. エミッタ: Emitter
 2. ベース: Base
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)



(JEDEC TO-39)

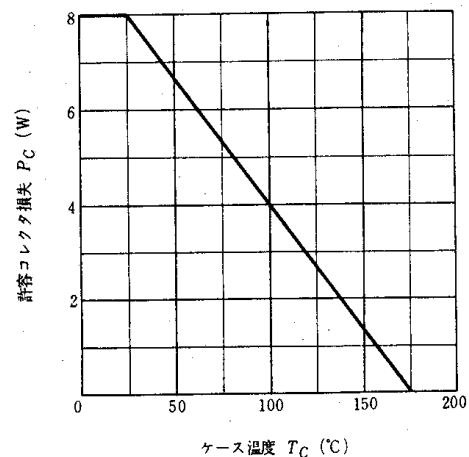
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SC1879 ^H	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	2	A
せん頭コレクタ電流	$i_C(\text{peak})$	4	A
許容コレクタ損失	P_C	0.8	W
	P_{C^*}	8	W
接合部温度	T_j	175	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	120	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}$, $I_E=0$	—	—	100	μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=100\text{V}$, $R_{BE}=\infty$	—	—	0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=2\text{A}$ *	1000	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}$, $I_B=4\text{mA}$ *	—	—	1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2\text{A}$, $I_B=4\text{mA}$ *	—	—	2.0	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=2\text{A}$, $I_{B1}=-I_{B2}=4\text{mA}$	—	0.5	—	μs
ターンオフ時間	t_{off}		—	4.2	—	μs

* パルス測定

* Pulse Test